
	<p><b>SI2333DS-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI2333DS-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 12V 4.1A SOT23-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI2333DS-T1-GE3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 144375 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2333DS-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 4.1A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	144375 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 4.1A (Ta) 750mW (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	32 mOhm @ 5.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 6V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2333DS-T1-GE3-ND

SI2333DS-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI2333DS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2333DS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2333DS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI2333DDS-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 6A SOT23</p>	 <p><b>SI2334DS-T1-E3</b> V SI2334DS-T1-E3 V</p>	 <p><b>SI2333DS-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 4.1A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2333DS</b> 89K SI2333DS 89K</p>
 <p><b>SI2334DS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4.9A SOT-23</p>	 <p><b>SI2333DS-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 4.1A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2333DS-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 4.1A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2334DS-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.9A SOT-23</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI2328DS-T1	↔ SI2328DS-T1-E3	⇒ SI2328DS-T1-E3	D SI2328DS-T1-GE3	↔ SI2328DS-T1-GE3
⊖ SI2329DS-T1-E3	⊕ SI2329DS-T1-GE3	D SI2329DS-T1-GE3	⇒ SI2331DS	↔ SI2331DS-T1-E3
⊕ SI2331DS-T1-E3	⊖ SI2331DS-T1-GE3	⊕ SI2331DS-T1-GE3	↔ SI2333ADS-T1-GE3	↔ SI2333CDS
D SI2333CDS-T1-E3	⊕ SI2333CDS-T1-E3	⊖ SI2333CDS-T1-GE3	⊕ SI2333CDS-T1-GE3	↔ SI2333DDS-T1-E3
⇒ SI2333DDS-T1-GE3	↔ SI2333DDS-T1-GE3	⊕ SI2333DS	⊖ SI2333DS-T1-E3	↔ SI2333DS-T1-E3
↔ SI2333DS-T1-GE3	⇒ SI2334DS-T1-E3	D SI2334DS-T1-GE3	⊕ SI2334DS-T1-GE3	⊖ SI2335DS-T1
⊕ SI2335DS-T1-E3	D SI2335DS-T1-E3	⇒ SI2335DS-T1-GE3	↔ SI2335DS-T1-GE3	↔ SI2336DS-T1-E3
⊖ SI2336DS-T1-GE3	⊕ SI2336DS-T1-GE3	↔ SI2337DS	⇒ SI2337DS-T1-E3	↔ SI2337DS-T1-E3
⊕ SI2337DS-T1-GE3	⊖ SI2337DS-T1-GE3	⊕ SI2338DS-T1-E3	D SI2338DS-T1-GE3	↔ SI2338DS-T1-GE3
↔ SI2341DS	⊕ SI2341DS-T1-E3	⊖ SI2341DS-T1-E3	⊕ SI2341DS-T1-GE3	↔ SI2341DS-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

